



⑧ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑫ Patentschrift
⑩ DE 100 33 112 C 2

⑧ Int. Cl. 7:
H 01 L 51/40
H 01 L 51/20
G 06 K 19/08

⑪ Aktenzeichen: 100 33 112.2-33
⑫ Anmeldetag: 7. 7. 2000
⑬ Offenlegungstag: 24. 1. 2002
⑭ Veröffentlichungstag
der Patenterteilung: 14. 11. 2002

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

⑬ Patentinhaber:
Siemens AG, 80333 München, DE

⑭ Erfinder:
Bernds, Adolf, 91083 Baiersdorf, DE; Clemens,
Wolfgang Dr., 90617 Puschendorf, DE; Fix, Walter
Dr., 90762 Fürth, DE; Rost, Henning Dr., 91056
Erlangen, DE

⑮ Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
gezogene Druckschriften:

DE 198 51 703 A1
DE 37 27 214 A1
US 57 05 826
EP 7 86 820 A2

BAO, Z. et al.: "High-Performance Plastic Transistors Fabricated by Printing Techniques" in
"Chem. Mater", 9 (1997) 6, pp. 1299-1301;
GARNIER, F. et al.: "All-Polymer Field-Effect
Transistor Realized by Printing Techniques" in
"Science" 256 (1994), pp. 1684-1686;
C.J. Drury et al.: "Low-cost all-polymer
integrated circuits" in: "Applied Physics
Letters", 73 (1998) 1, pp. 108-110;
M. Angelopoulos and J.M. Shaw: "In-Situ Radiation
Induced Doping", in: "Mol. Cryst. Liq. Cryst.",
189 (1990), pp. 221-225;

⑯ Verfahren zur Herstellung und Strukturierung organischer Feldeffekt-Transistoren (OFET), hiernach gefertigter
OFET und seine Verwendung

⑰ Verfahren zur Herstellung eines organischen Feldeffekt-Transistors (OFET) durch Drucken von zumindest ei-
nem Funktionspolymer auf ein Substrat in einem Tam-
pondruckverfahren, wobei das Funktionspolymer zu-
nächst in eine mit herkömmlichen Druckfarben vergleich-
bare Konsistenz gebracht und dann auf das Substrat auf-
gedruckt wird.

